深圳市晶泰源电子有限公司

MJE13003 NPN 晶体管

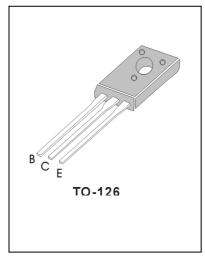
特点: 耐高压 开关速度快 安全工作区宽 符合 RoHS 规范

应用: 节能灯 电子镇流器

1、 封装形式: TO-126

2、极限参数(绝对最大额定值 Ta=25℃)

参数名称	符号	参数值	单位
集电极-基极电压	BV _{CBO}	600	V
集电极-发射极电压	BV _{CEO}	400	V
发射极-基极电压	BV _{EBO}	9	V
集电极最大电流	I _{CM}	1.5	A
耗散功率	P _C	20	W
最高工作温度	Tj	150	${\mathbb C}$
贮存温度	Tstg	-65∼+150	Ç



3、电参数特性 (Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	最小值	参数值 典型值	最大值	单位
集电极−基极电压	BV _{CBO}	$I_{C}=100 \ \mu \ A$, $I_{E}=0$	600			V
集电极-发射极电压	BV _{CEO}	$I_C=10\text{mA}$, $I_B=0$	400			V
发射极-基极电压	BV _{EBO}	$I_E=100 \mu$ A, $I_C=0$	9			V
集电极-基极漏电流	I _{CBO}	V_{CB} =600V, I_{E} =0			100	μA
集电极-发射极漏电流	I _{CEO}	V_{CE} =400 V , I_{B} =0			250	μA
发射极-基极漏电流	I _{EBO}	$V_{EB}=9V$, $I_{C}=0$			100	μΑ
直流放大倍数	H _{FE} (1)	$V_{CE}=5V$, $I_{C}=1mA$	7			
	H _{FE} (2)	V_{CE} =10 V , I_{C} =0.1 mA	10		40	
饱合压降	V _{CESAT}	$I_{C}=0.2A$, $I_{B}=0.04A$			0.3	V
正向压降	V_{BESAT}	I_{C} =0.2A, I_{B} =0.04A			1.2	V
存储时间	t _s	$V_{\rm CC}$ =5V, $I_{\rm C}$ =0.25A	1.5		3.5	μS
下降时间	$\mathbf{t_f}$	(UI9600)			1.0	μS

深圳市晶泰源电子有限公司

电话:83211536 传真:83206326

地址:华强广场C座11C室